### **JEITA**

国際競争時代における連携強化・応用分野新事業の可能性に貢献する

## 半導体標準化専門委員会 の活動紹介

Activities on Semiconductor Standardization Committee 2017

#### 一般社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

http://www.jeita.or.jp/

半導体標準化専門委員会では、半導体デバイスについての規格類(用語、特性項 目、特性の評価(測定)方法、環境試験及び耐久性試験方法など)に関してIECを中心 にした国際標準化活動を行っています。半導体パッケージ技術委員会、集積回路製 品技術委員会、個別半導体製品技術委員会、半導体信頼性技術委員会、半導体&シ ステム設計技術委員会の 5 つに分かれて、半導体に関わる標準化等の幅広い活動 を行っています。主な取組みは次のとおりです。

#### ◆半導体パッケージング技術委員会

顧客の利便性を考慮し、同じプリント基板に何社もの半導体が載せられるよう、設 計ガイドラインや調査内容の報告書を発行しています。パッケージ外形のみならず、 後工程全体の標準化テーマも審議すべく技術委員会の名称を半導体パッケージから 半導体パッケージングに致しました。審議案件として、パッケージ外観基準、パッケー ジ用サブストレートの外観基準、パッケージ名称及び組立に関する用語の統一、出荷 用包装材のデザインガイドや用語集、熱設計に必要となる半導体モデルの規格化や 材料物性測定法についてのガイドラインなどがございます。本年度から、パワー半導 体パッケージの審議もスタート致しました。

#### ◆集積回路製品技術委員会

メモリSC、半導体EMC-SC、3D-半導体/モジュールSCの合計3つのサブコミティ から構成されています。

メモリSCでは、年4回行われるJEDECの各Committeeに積極的に参加していま す。DDR4 DIMM、LowPower DRAM に加え、HBM、UFS/eMMC 等の Flash メモリにも 関与し、合計で年間 100 件の Ballot 発行および承認を図っています。

半導体 EMC-SC では、半導体 EMC に関する標準規格の策定に関する活動を行っ ています。具体的には、エミッション・イミュニティ測定法、半導体EMCモデル、車載ネ ットワーク測定法の標準規格を策定します。

3D-半導体/モジュール SC では、3D-IC に必要となるチップ間 I/F 仕様や TSV 測定 方法の IEC 提案を目指して検討を進めます。またロジックチップ間 I/F について、イン ターポーザを使って配線実現性や電気特性の検証を行います。

#### ◆個別半導体製品技術委員会

トランジスタ、ダイオードをはじめ発光ダイオードなど、ディスクリートデバイスの特 性や測定方法などの標準化規格作成に取り組んでいます。また IEC/TC47 の SC47E における、マイクロ波デバイス、パワーデバイス、発光ダイオードなどの IEC 規格の 制定や改正に関し、標準化活動の支援をしています。

昨年度は、JEITA 規格改正が完了した絶縁ゲートバイポーラトランジスタ規格 (ED-4562B)化の IEC 提案を開始し、日本発となる IEC 規格提案の LED 硫化試験法に ついての審議も開始しています。JEITA 規格は、電界効果パワートランジスタの JEITA 規格(ED-4561A)の改正および発光ダイオード の JEITA 規格(ED-4912)の改 正、マイクロ波デバイス規格(ED-4359)の改正について着手しています。

#### ◆半導体信頼性技術委員会

半導体信頼性試験規格、半導体の認定試験計画に関するガイドライン、ソフトエラ 一に関する試験法ガイドライン、ウェーハレベル故障メカニズムと試験方法規格化、 システムレベルの ESD に対する半導体取り扱いガイドライン作成と、ESD耐量の適 正化にも取組んでおり、JEITA 規格として標準化を進めると共に IEC/TC47 の直属の WGにおける、半導体デバイスの環境試験方法(WG2)への NP 提案を行う等、積極的 に国際標準化を推進しています。また、これらの規格について、国内の一般者向け のセミナーも定期的に開催して、規格・ガイドラインの普及を進めています。

#### ◆半導体&システム設計技術委員会

電子機器の機能・性能を決定するシステム LSI の設計技術に関する活動を行ってい ます。IEC の SC47A および TC91/WG13 の国内委員会や標準化関連組織 (IEEE/DASC、IEEE-SA 等)と連携し、設計技術およびそれに関わる標準化の推進に よって、国内外の関係業界の発展に寄与することを目的としています。

2016 年度は LSI・パッケージ・ボード相互設計-SC、国際標準化・企画-WGを設置し、 日本発 EDA 関連 IEEE 規格としては初めての制定となった IEEE Std 2401TM-2015(LPB標準フォーマット)の拡張並びに更なる設計現場への普及に取り組 みます。

#### 半導体標準化専門委員会参加企業一覧/委員会組織

Member Companies / Organization

<2017 年度(平成29 年度)組織体制> (敬称略)

委員長:瀬戸屋(東芝)

副委員長: 冨島(東芝)、加藤(東芝)、福場(東芝)、吉田(パナソニック)

マイクロンメモリジャパン(株)

三菱電機(株)

ミツミ電機(株)

(株)村田製作所

ユニテクノ(株)

(株)リコー

ローム(株)

(株) I D A J

新日本無線(株)

トヨタ自動車(株)

日亜化学工業(株)

(株)メモリエキスパート

メンター・グ ラフィックス・ジャパン(株)

ルネサスエレクトロニクス(株)

(オブザーバ)

(株)ジェム・デザイン・テクノロジーズ

シナプティクス・ジャパン(株)

(株) ソフトウェアクレイドル

デバイス・アナリシス(株)

(株)東レリサーチセンター

(株)日立パワーデバイス

アンシス・ジャパン(株)

キーナスデザイン(株)

<2017 年度(平成 29 年度)参加企業 50 社]>(順不同·敬称略)

エスペック(株) 沖電気工業(株) キヤノン(株) 京セラ(株) (株) クオルテック

システム・ソリューションス゛(株)(オン・セミコンタ゛クター)

新電元工業(株) スタンレー雷気(株) (株)図研

セイコーエプソン(株) (株) ソシオネクスト

ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) (株)台和

(株) デンソー (株)東芝

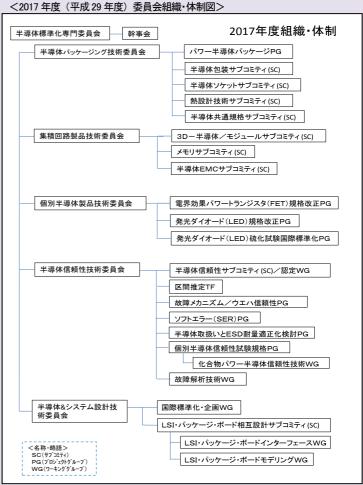
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 日本シノプシス合同会社

日本電子(株) (株)ノイズ研究所 HIREC(株) (株)バッファロー パナソニック(株) 浜松ホトニクス(株)

富士通アドバンストテクノロジ(株)

富士電機(株) 古河電気工業(株)

(株)日立製作所



当委員会では、IoT等の新たな展開を先取りして、国内他機関と連携し、より付加価値の高い、幅広い領域での標準化技術活動を推進し、アジアにおける日本のリーダーシップ強化を図るとともに、会員企業の収益向上につながる有用な標準と技術情報を提供しております。

 半導体パッケージング技術委員会
 パワー半導体パッケージPG

 半導体包装サブコミティ(SC)

 半導体ソケット サブコミティ(SC)

 熱設計技術サブコミティ(SC)

 半導体共通規格サブコミティ(SC)

毎年セミナーを行っており、昨年度は 2 月に熱設計セミナー「2016 年度 熱設計技術セミナー」を行いました。

13:00-13:05	開会挨拶 熱設計技術サブコミティ(SC)主査	熊野 豊 [パナソニック(株)]
13:05-13:55	「熱設計におけるファンのモデル化」 防衛大学校 システム工学群 機械工学科	教授 中村元氏
13:55-14:35	「JEITA熱設計技術サブコミティの取り組み」	
14:35-14:45	休 憩	
14:45-15:35	「プリント基板の面内方向熱伝導率測定法」 株式会社アドバンスドナレッジ研究所 技術廳	間 大串 哲朗 氏
15:35-16:15	「半導体の発熱量予測(仮)」 熱設計技術サブコミティ(SC)	委員 瀧澤 登 [ロ―ム(株)]
16:15-16:55	「半導体部品における実測ベースでの三次元熱解析技術」 熱設計技術サブコミティ(SC)委員 羅 「メンターグラフィ	
16:55-17:00	閉会挨拶 熱散計技術サブコミティ(SC)主査	熊野 豊 [パナソニック(株)]



次に当小委員会傘下の5つのサブコミティ(SC)・プロジェクトグループ(PG)、パワー半導体パッケージ、半導体包装、半導体ソケット、熱設計技術、ならびに半導体共通規格のそれぞれの活動をご紹介します。

#### 【パワー半導体パッケージPG】

当PGでは、パワー半導体パッケージング標準化国際規格の普及・拡大を図っていく上で、統一されていない為に障害となっている事項(例: 寸法・公差の入れ方、測定法等)の最新状況・最新動向を関係者から情報を集め、標準化アイテムを模索し、日本発の新規提案を開発・審議しております。

化合物半導体パワーパッケージの標準化アイテムを模索し、必要な事項の標準化を進めております。(例:幾何公差、基準面の取り方・ベース面のそりの規定方法) 本PGでの活動結果は JEITA 規格として纏めると共に、必要に応じて IEC 規格への

提案を行う予定です。

#### 【半導体包装サブコミティ】

当サブコミティは、「半導体包装に関する規格案の企画、審議と発行、技術報告書の作成」「IEC/TC40/WG36(半導体を含む実装部品の包装材関連規格)国内委員会へ参画し関連事項に対応」「JEDEC との関連事項への対応」を活動目的としています。2016年度は、既存規格類のメンテナンスや改正を検討していくとともに、包装材に関する「包装材料用語集(ED-7618)」、「マトリクス固定トレイデザインガイド(ED-7607)」の制定致しました。2017年度はIEC/TC40 60286シリーズの改正を中心に、包装材の静電気対応を含めて審議しております。

#### 【半導体ソケットサブコミティ】

当サブコミティでは、半導体デバイス製品の機能試験ならびに信頼性試験のためのソケットに関する規格類の制定・改正などの標準化活動を推進しています。 引続き、既存の規格類の見直しを検討予定です。

#### 【熱設計技術サブコミティ】

当サブコミティでは、電子機器の熱設計において、OK/NG の判断指標となる半導体ジャンクション温度の導出方法や予測方法の規格化に取り組んでおります。

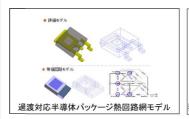
これまでの取り組みとしては、半導体パッケージの熱特性パラメータの定義および 熱設計時に使用する際の注意点に関するガイドラインを作成いたしました。また半導 体パッケージの熱特性パラメータがない場合において、パッケージタイプや形状等々 から熱特性パラメータを予測するツールを提供いたしました。

現在の取り組みですが、特に過渡変動の要求が厳しいパワー半導体パッケージ向け過渡対応半導体パッケージ熱回路網モデルや、これまで熱特性パラメータを実験的に取得できなかった狭ピッチ半導体パッケージ対応熱特性評価基板、それに半導体パッケージのシミュレーションモデル作成に必要な情報を共有するための高精度を担保した半導体パッケージの簡易熱モデルの規格化に取り組んでおります。

また国際標準化活動も積極的に行っており、2016年10月のIECフランクフルト大会において、半導体パッケージの熱特性パラメータの使用方法に関する IEC 規格化提案を行いました。



http://semiconjeitassc.jeita-sdtc.com/tcsp/sc\_pg/ttd/PKG\_Thermal\_Calculator\_agree.php





#### 【半導体共通規格サブコミティ】

当サブコミティは、EC SC47D/WG2 の案件を扱い、パッケージの JEITA 規格作成 の共通ルールの規格化等を目的として発足され、半導体メーカーと顧客との双方に 有益なパッケージ図面の書き方や、歩留の上がる幾何公差の設定の仕方、パッケージの呼び方などを審議・検討してまいりました。

昨今、パッケージングを取り巻く状態が変化してきており、半導体サプライヤはパッケージを委託生産・調達する側になってきたことを背景に、当サブコミティでは、サプライチェーン上のインターフェースとして、用語・外観基準など、すべての国際企業が必要な技術を取りまとめていくことにしました。

2016 年度継続して審議を行う案件は、アセンブリ・パッケージング全般の用語の統一、パッケージの外観基準、パッケージ基板の外観基準などです。これらは、2014 年度、IEC東京大会にて、日本から審議の提案を行い、世界中の国々から期待されており、半導体裾野産業を含めたオールジャパンとして取り組まねばならないテーマだと考えています。一方、市場から粗悪品を排除し、品質の良い日本製のシェアを高める良い機会だと考えており、日本企業全体の為にも国際市場で有利に立てるような規格づくりを鋭意進めてまいります。

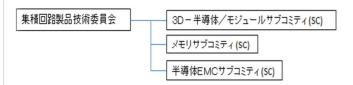
<2017 年度(平成29年度)組織体制>

主 査: 吉田(パナソニック) 参加企業:16社(順不同・敬称略)

新電元工業(株)、(株)台和、(株)デンソー、(株)東芝、パナソニック(株)、富士電機(株)、富士通アドバンズトテクノロジ(株)、マイクロンメモリジャパン(株)、メンター・グラフィック・ジャパン(株)、山一電機(株)、ユニテクノ(株)、ルネサスエレクトロニクス(株)、ローム(株)、(株)IDAJ、キーナスデザイン(株)、

(株)ソフトウェアクレイドル

当委員会では、半導体メモリ、半導体 EMC、3D-半導体/モジュールの各分野における技術的課題に対する研究、調査を行い、JEDEC 及び IEC/SC47A にて開発が推進される国際標準規格に対する標準化活動を行っています。



#### 【3D-半導体/モジュールサブコミティ】

LSIの微細化が進み開発費の高騰、開発期間の長期化で、少量多品種の開発の負担が増しています。様々なチップを組み合わせたマルチチップ設計を行う場合でも、現状では開発期間や開発費用がかさむため、Time to market のためのマルチチップ1/F設計仕様が必要となります。

3D-半導体/モジュールサブコミティでは、TSV を用いた 3D/2.5D のマルチチップ設計において必要となる情報(TSV 要件、チップ間の I/F 他)にフォーカスして、標準化の議論を進めています。現在マルチチップ実装において不可欠な接続部(TSV)の測定法(提案中)について、標準化のための作業を進めています。また 3D-IC ダイ間のテスト手法について、標準化のための議論を進めています。

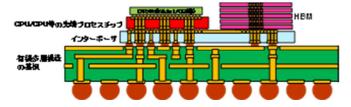
#### (1)2016 年度活動紹介

- ・3D-半導体に使われる TSV 構造の回路モデルとその測定方法 IEC SC47A ボストン大会にて NP 案が可決
- フランクフルト大会(10月)を経て10/24にCDを提出 ・各種インターポーザー(Si/Glass/樹脂)での実証実験
- 樹脂インターポーザーをモチーフとした評価パターンの試作を完了
- ・次期標準化アイテム探索

3D-IC ダイ間のテスト手法に着目して研究開発動向のヒヤリングを実施(2)2017 年度活動計画

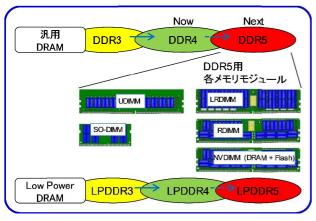
- ・3D-半導体に使われる TSV 構造の回路モデルとその測定方法 規格化の作業を継続して推進
- ・各種インターポーザー(Si/Glass/樹脂)での実証実験 樹脂インターポーザー試作機版の評価 その他材料(Si/Glass)の調査継続
- ・次期標準化テーマ

アナログバウンダリスキャン回路による 3D-IC ダイ間のテスト手法を選択標準化の検討を実施



#### 【メモリサブコミティ】

メモリサブコミッティは、JEDEC 標準化策定の初期段階から関与し、戦略的に日本工業会の要求を反映させ、グローバルスタンダード化を目指しています。JEDEC の主に JC42 および JC45 を中心に、直接提案活動を行っています。



JC42 では汎用 SDRAM 単体仕様(JESD79 関係、JESD209 関係)規格化を行っています。主記憶として用いられる汎用 SDRAMは年々高速化、低消費電力化が要求されています。デスクトップ PC,サーバー等で用いられる次世代 DDR SDRAM であるDDR5、及びノート PC, タブレット端末、携帯電話等で用いられる次世代 Low Power SDRAM である LPDDR5 の標準化に関する技術的な議論を行っています。

JC45ではメモリモジュール仕様 (JESD21)の規格化を行っています。次世代汎用 SDRAM である DDR5 を搭載するモジュール仕様の議論を行っています。また近年では不揮発性メモリである Flash メモリと主記憶である汎用 SDRAM を混載したハイブリッドモジュールの議論を行っています。

また汎用 SDRAM の高速化に伴い、メモリインターフェースの特性測定方法の標準 化の要求が高まっており、2017 年より検討を開始しました。

#### 【半導体 EMC サブコミティ】

半導体 EMC(Electromagnetic Compatibility:電磁両立性)サブコミティは規格審議、 実証実験と広報 WG(Working Group)の3つのグループで構成されており、連携して活動しています。

規格審議 WG は、IEC SC47A WG2・WG9 での国際規格策定に対応し、EMC シミュレーション用の半導体モデリング方法 (IEC 62433 シリーズ)、半導体の EMC 性能測定方法 (エミッション:IEC 61967 シリーズ、イミュニティ:IEC 62132 シリーズ、インパルスイミュニティ:IEC 62215 シリーズ、トランシーバ測定:IEC 62228 シリーズ)の標準化活動を行っています。

実証実験WGでは、国際規格の妥当性検証のために、IEC 62228 シリーズのうち、 CANトランシーバと日本から規格提案予定のCXPIトランシーバの実測とシミュレーションの試行を行い、妥当性の検証を行っています。

広報 WG では、半導体 EMC セミナーの開催や他の団体との連携活動により、最新情報の提供を行っています。

#### (1)2016 年度活動紹介

- ・測定法(4件)とモデリング(4件)に関する国際規格案の審議と投票。
- ・エミッション測定法(1件)の改訂版作成と提案
- ・トランシーバ測定法(1件)の新規作成を開始。 クライテリアの設定の為、半導体 EMC 測定ボードを作成し、測定を開始。
- ・半導体 EMC セミナーを開催。 半導体国際規格の解説とともに、エキスパートを招聘し製品レベルの EMC に関する講演を行うことで多角的に EMC 問題を考える場としました。



2017年1月に開催した半導体EMCセミナー会場全景

#### (2)2017 年度取り組み計画

- ・測定法及びモデリング方法規格案の審議を行い、国際会議(仏ツールーズ、独レーゲンスブルグ会議)へ委員を派遣し、国内意見を反映させる
- ・トランシーバ規格を対象とした、試験方法やリミット値の妥当性の検証を行う。
- ・モデリング規格と設計データフォーマット規格において、そのフォーマット間の 整合を確認し、解析効率向上に向けた検討を行う。

<2017 年度(平成29 年度)組織体制>

主 査: 冨島(東芝)

副主査:英(パナソニック)、川畑(ソニー)、

監事:稲垣(ローム)、

参加企業:12社(順不同・敬称略)

キヤノン(株)、ソシオネクスト(株)、ソニー(株)、(株)デンソー、

(株)東芝、(株)ノイズ研究所、(株)バッファロー、パナソニック(株)、

(株)メモリエキスパート、ルネサスエレクトロニクス(株)、

ローム(株)、アンシス・ジャパン(株)

当委員会では、トランジスタ、ダイオードをはじめ発光ダイオードなど、ディスクリートデバイスの用語とその定義や記号、特性測定方法などの標準化・規格作成に取り組んでいます。

JEITA 規格はもとより IEC 規格についても TC47/SC47E 国内委員会と連携して、ディスクリート半導体デバイスの規格立案・審議を進めています。

#### 【2017年度の委員会構成】

#### 個別半導体製品技術委員会

Discrete Semiconductor Technical Committee

※3つのプロジェクトでIEC規格及びJEITA規格の改正を進める

LED規格改正PG (JEITA ED4912の改正)

電界効果パワートランジスタ規格改正PG (JEITA ED4561Aの改正)

LED硫化試験国際標準化PG

※3つのデバイスグループ毎に、標準化テーマに取り組む

マイクロ波デバイス Gr

パワーデバイス Gr

オプトデバイス Gr

#### 【電解効果パワートランジスタ規格改正PG】

2015 年度よりスタートした、JEITA ED-4561A(FET規格)の改正を進めているPGです。2017 年度末に改正規格の発行を行えるように審議推進しています。

#### 【LED 規格改正PG】

2016 年 9 月よりスタートし、JEITA ED-4912(LED 規格)の改正を進めている PG です。2017 年度末に改正規格の発行を行えるよう審議推進しています。

#### 【LED 硫化試験国際標準化 PG】

2016 年11 月よりスタートし、試験規格見極めのクロステストを実施し、IEC 規格化を目標に活動を開始しています。2017 年度は、IEC 規格への NP 提案を行う予定です。

#### 【マイクロ波デバイスGr】

IEC/SC47E/WG2 に対応するデバイスの担当グループです。

JEITA 規格の立案・管理や IEC 規格の立案・審議などを行っています。

2014 年度に、JEITA 規格類の統廃合を決定し、統合規格の(ED-4359)の規格化を 決定、2015~2016 年度で、マイクロ波半導体デバイス規格 JEITA ED-4359 の改正 を推進してきました。

2017 年度は、JEITA ED-4359A(改正版)の発行を目指しています。また、IEC60747-16-6(マイクロ波集積回路・周波数逓倍器)の CDV 発行を目指した規格審議も進めていきます。



FD-4359

#### 【パワーデバイスGr】

IEC/SC47E/WG3 に対応するデバイスの担当グループです。

JEITA 規格の立案・管理や IEC 規格の立案・審議などを行っています。

2015 年度は、絶縁ゲートバイポーラトランジスタの JEITA 規格改正(ED-4562B)を終了し、改正規格を発行しました。

2016年度は、2015年度にスタートした電界効果パワートランジスタの JEITA 規格改正 (ED-4561B)の審議を行ってきました。

2017年度は、ED-4561Bの発行を目指しています。また、2015年に規格改正した絶縁ゲートバイポーラトランジスタ規格のIEC 提案も推進中で、本年度に CC 発行を目指します。

#### 【オプトデバイスGr】

IEC/SC47E/WG4 および SC47E/MT6 に対応するデバイスの担当グループです。 JEITA 規格の立案・管理や IEC 規格の立案・審議などを行っています。

2015 年度は、IEC60747-5-6/7 の IS(規格発行)を行ないました。

2016年度は、JEITA ED-4912(LED 規格)の改正に向けた審議をスタートし、さらにLED 硫化試験国際規格制定に向けた新しい PG を立ち上げ、IEC SC47E に PWI 提案を行いました。

2017年度は、審議中のED-4912規格改正を完了させ、LED硫化試験国際規格化に向けた IEC 規格 NP 提案を目標に活動を行います。





ED-4561A

ED-4912

#### 【関連委員会活動】

2009 年度から2014 年度までの6年間、半導体パッケージ技術小委員会メンバーと 共に、半導体デバイス国際標準化活動推進委員会(PCSS: Promotion Committee on Semiconductor device Standardisation)に参画し、マレーシア、シンガポール、タイを始めとするアジア諸国にIEC 活動への参加を働きかけました。

2015 年度は、PCSS の成果により、シンガポールで個別半導体のミーティングを開催することができました。

2016 年度は、タイで開催される APSG セミナーに参加するなど、アジア諸国への働きかけを継続してきています。 今後も、国際規格化推進するための IEC/TC47 活動への参加を働きかける予定です。

<2017 年度(平成29年度)組織体制>

主 査:加藤(東芝)

副主査:大芝(ソニー)、小川(スタンレー電気)、角田(三菱電機)

参加企業:18社(順不同・敬称略)

三菱電機(株)、ソニー(株)、スタンレー電気(株)、(株)東芝、新電元工業(株)、

富士電機(株)、ルネサスエレクトロニクス(株)、オン・セミコンダクター(株)、

ローム(株)、日亜化学工業(株)、パナソニックセミコンダクターソリューションズ(株) シャープ(株)、浜松ホトニクス(株)、京セラ(株)、住友電気工業(株)

(株)日立パワーデバイス、(株)明電舎

当委員会では、半導体信頼性に関する標準化規格制定を推進しています。半導体の認定試験計画に関するガイドライン、ソフトエラーに関する試験法ガイドライン、ウェハレベル故障メカニズムと試験方法規格化、システムレベルの ESD に対する半導体取り扱いガイドライン作成と、ESD耐量の適正化にも取組んでおり、JEITA 規格として標準化を進めると共に JEDEC JC-14 との整合、IEC/TC47 の直属の WG における、半導体デバイスの環境試験方法(WG2)への NP 提案を行う等、積極的に国際標準化を推進しています。 また、これらの規格について、国内の一般者向けのセミナーも定期的に開催して、規格、ガイドラインの普及を進めています。

特に JEDEC/JC14(信頼性技術委員会)との合同会議(Joint Meeting)を年1回行い、JEITAと JEDEC における規格案の情報交換と規格内容のハーモナイズをした上で、IEC/TC47 へ規格提案する活動を進めています。

以下に半導体信頼性技術委員会の組織(体制)および傘下の SC,各 PG,WG の 2016 年度の活動状況ならびに 2017 年度の活動計画を示します

# 半導体信頼性技術委員会 2017年度体制 半導体信頼性サブコミッティ/認定WG 個別半導体(パワー系)信頼性試験規格PG 化合物パワー半導体信頼性技術WG 故障メカニズム/ウェハ信頼性PG ソフトエラー検討PG ソフトエラー検討PG カメラモジュール試験方法検討PG カメラモジュール試験方法検討PG 故障解析技術WG 故障解析技術WG

#### ■半導体信頼性サブコミティ(SC)

区間推定TF

2016 年度は、(1) EDR-4704A「半導体デバイスの加速寿命試験運用ガイドライン」の改正、(2) ED-4701/301A「はんだ耐熱性試験」改正版完成しました。また、半導体信頼性試験認定ワーキンググループと協働で、EDR-4708B 信頼性認定ガイドライン第3版を完成させました。

2017 年度は、(1) EDR-4708C 信頼性認定ガイドライン第4版検討(認定 WG との協働し、初期故障(m<<1)に適用する区間推定の検討、信頼性試験計画時に活用できる評価項目一覧を追加する)。(2) EDR-4704A 加速寿命試験運用ガイドラインの改正し、位置づけをEDR-4708Bの教科書的な内容として、加速モデル、パラメータの最新化を加えて、2017 年9 月完成を目指します。 またこられの内容は JEDEC とのJoint Meeting(2017 年9 月)にて規格のハーモナイズを進めます。

#### ■半導体信頼性試験認定ワーキンググループ(WG)

自動車用半導体を中心とする認定試験のガイドライン(EDR-4708A)については、 IEC TC47/WG2 国際標準化については改訂版の CDVが 2016 年 12 月に可決され、 日本提案: 世界標準 IEC 60749-43 として国際標準になる事が、決定しました。

2017 年度中の国際標準化を目指して進めていきます。2017 年度は、高温下など高信頼性要求される用途向けに使用環境温度を考慮したミッションプロファイルによる信頼性認定計画基準と評価計画時に活用できる評価項目一覧を追加できるよう進めていきます。また本規格普及のために積極的にセミナーを開催していきます。

#### ■個別半導体(パワー系)信頼性試験規格プロジェクトグループ (PG)

当該 PG では、パワーデバイスとしての車載用個別半導体製品の認定ガイドの策定を進め、1)スクリーニング方法、2)アバランシェスクリーニング、3)TDDB評価法、ゲートスクリーニング、4)サンプルサイズのガイドを含めた規定を EDR-4711(日本語版)を 2016 年 2 月に制定し、品質グレード、故障分布、試験項目を見直した改訂版 EDR-4711Aを17年3月発行ました。また、2016年度もドイツの自動車メーカー5社が作成した、パワーモジュール認定規格 LV324との試験方法の整合についても、今後、定期的な打合せを実施しました。その結果、本規格はパワーデバイスをパワーモジュール限定とし、JEITA EDR-4711は、デバイスメーカーの信頼性データ取得ガイドライン、LV324は、車載用パワーモジュールの認定規格として位置づけの明確化と、棲み分けを行いました。

#### ■化合物パワー半導体信頼性技術ワーキンググループ (WG)

2016 年度は、国プロと連携して、「SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法 (Part 1:結晶欠陥の分類)」をIEC TC47 WG5 へ NP 提案を行いました。 2017 年度は、 Part2 として、SiC エピ欠陥の非破壊検査方法を 2017 年 3 月に制定しました。

また、化合物パワー半導体に固有かつ普遍的な故障メカニズ"を抽出し、故障モード検出に適切なモデル検証と試験方法の検討を行い、SiCでは耐久性試験方法3件と SEBの規格化、GaNでは耐久性試験方法2件とSEBの規格化の内容整合を行い、 2017年7月の制定を目指して進めていきます。

#### ■故障メカニズム/ウェハ信頼性プロジェクトグループ(PG)

2016 年度は Copper Stress Migration 基準日本案を 2011 年に JEDEC に提案して以来議論を続け 2014 年度に JEDEC 基準としてまとめることができ、IEC 基準として提案し 15 年度に CD,16 年度は CDV を提出し無事承認を受けることができました。 現在 FDIS を回付中であり事実上、IEC 規格化できました。 本基準は日本が提案してきた製品レベルの規模換算の基準を盛り込んだもので、ファンダリーに製品レベル信頼性まで、保証要求が可能になる画期的な規格になっています。

2017 年度は、半導体の故障メカニズムをまとめた EDR-4707 の最新動向を含め改正を進めます。また Copper Stress Migration 以外の項目も基準化を進めそれらを束ねた Foundry 基準の JEDEC/IEC 基準化を目指します。

#### ■ソフトエラー検討プロジェクトグルーブ(PG)

いきます。

2016 年度に仮定した EDR-4705A に準拠した (ソフトエラー試験ガイドライン) に準拠した IEC60749-44 国際規格化が完了しました。2017 年度は、 JEDEC-JESD89B/-1B/-2B/-3B( ソフトエラー試験法)の改訂作業を連携して進めて

#### ■半導体の取り扱いとESD 耐量適正化プロジェクトグループ(PG)

ESD 耐量適正化PGでは、管理された工程ではHBM:1000V,CDM:500Vの新ガイドラインと、市場での発生の可能性の無い MM の廃止を明記した「半導体取り扱いと ESD 耐量適正化のガイドライン」(EDR-4710)として策定して 2015 年 3 月に発行しました。また 2016 年度は RCJ(TC101-JP)と連携した CDMS 管理方法標準化検討 IEC-TC47 にて半導体デバイスの要求内容として国際標準への提案を進めてきました。 2017 年度も、引き続き RCJ と連携して CDMS 管理方法標準化を進めていきます。

#### ■故障解析技術ワーキンググループ(WG)

2016 年度から、故障解析技術 WG を新たに発足させ、LVP,LVI,EOP 等の故障解析 用語の統一や、標準の故障解析手順のガイドライン作成を検討しました。内容につい てはほぼ方針が固まり、2017 年度中にガイドライトンして制定できるようも継続して推 進していきます。

#### ■カメラモジュール試験方法検討プロジェクトグループ(PG)

2016 年度から、新たに発足させ、ガイドライン作成を検討していきます。2016 年度は、参加企業の募集に終始しましたが、2017 年度から、使用ユーザーによって試験方法、基準の異なるカメラモジュール試験方法について、統一規格化の制定を目指して活動開始して行きます。

#### ■区間推定タスクフォース(TF)

自動車用半導体を中心とする認定試験のガイドライン(EDR-4708A/IEC 60749-43)の IEC 提案の際に各国エキスパートからご指摘戴いた初期故障(m<< 1)に適用する区間推定方法の検討を行うため、2016 年度途中から、国内の信頼性統計のスペシャリスト及び信頼性技術委員会各 SC,WG,PG メンバーの有識者に参画戴き、新たに発足させたタスクフォースで、半導体故障率バスタブカーブの定義、スクリーニング後の統計的考え方などを統一見解としてまとめて、EDR-4708/EDR-4711 への反映を進めていきます。

<2017 年度(平成29年度)組織体制>

主 査:瀬戸屋(東芝)

副主査:中村(沖エンジニアリング)

監 事: 宮本(ソニー)

参加企業:25社(順不同・敬称略)

エスペック(株)、沖エンジニアリング(株)、クオルテック(株)、新電元工業(株)、(株)東芝、オン・セミコンダクター、、(株)ソシオネクスト、ソニー(株)、日本電子(株)、HIREC(株)、パナソニック(株)、浜松ホトニクス(株)、(株)日立製作所、富士電機(株)、三菱電機(株)、ローム(株)、ミツミ電機(株)、ルネサスエレクトロニクス(株)、メクター・グラフィックス・ジャパン(株)、(株)クオルテック、日本電子(株)、浜松ホトニクス(株)、シナプティクス・ジャパン(株)、トヨタ自動車(株)、(株)東レリサーチセンター、デバイス・アナリシス(株)

電子機器分野における競争は非常に厳しく、価値の高い製品を短期間で開発して 市場に投入することがビジネスの成否を決めます。また、リーマンショック以降、事業 構造の変革によりグローバルサプライチェーンの中での分業体制が進んでいます。 このような状況の変化から、"ものづくりエコシステム"の構築がこの開発競争に打ち 勝つ鍵となってきています。

当員会は、電子機器に半導体を部品として活用する場合に「半導体部品の最適な性能を発揮するための設計技術」を構築すべく、LSI・パッケージ・ボード(以下 LPB)に代表される電子機器の構成要素に関する情報を、このグローバルサプライチェーンの中に流通させるための標準化活動に取り組んでいます。



LPB による設計エコシステムの構築

#### 【半導体&システム設計技術委員会が注力する領域】

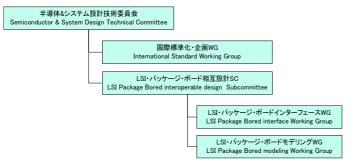
個別技術の単なる組み合わせでは差別化した商品を生み出せず、優秀な技術のいち早い採用とすり合わせによって、競争力のある製品を構想することが必要です。元来、日本の設計技術はこのようなすり合わせ設計を得意とし、差別化技術としてきました。しかしながら、グローバル調達が必要となった今日では、優秀な要素技術・設計パラメータを入手することが非常に困難となり、この差別化技術を効果的に発揮することが難しくなっています

この情報障壁は、各フェーズで設計に関わる情報の書式が統一されていないことが一因です。技術者が情報収集の為にサプライヤーや顧客と延々と会話を繰り返し、自社設計環境にマッチさせるための書式の変換に多くの時間を費やしています。このため、設計開始遅延のみならず、ミスや誤った情報に起因するやり直し、時間切れによる検証不足が原因となる動作不良が発生する恐れがあります。

当小委員会の活動は、流通すべき情報の書式を統一し、情報収集の迅速化・ミスの撲滅・手戻り削減を実現することで、構想を練るための十分な時間を確保し、設計品質を高めることを狙いとするものです。「半導体を設計・開発する立場」と「半導体や電子部品を使用し機器設計・開発を行う立場」の双方にとって共通技術となる、インターフェースの標準化に注力します。

#### 【2017年度の活動体制】

2017 年度は、戦略的標準化施策を検討する国際標準化・企画 WG 及び、IEC 63055/IEEE Std 2401TM-2015(LPB 標準フォーマット)の拡張ならびに、更なる設計現場への普及等に取り組む LSI・パッケージ・ボード 相互設計-SC(LPB-SC)を設置します。LPB-SC の下には、LSI・パッケージ・ボード インターフェース-WG(LPB IF-WG)と、ライブラリ・モデルの書式統一推進を目指す LSI・パッケージ・ボード モデリング-WG(LPB MDL-WG)を置きます。



2017 年度 半導体&システム設計技術委員会の活動体制

#### 【国際標準化・企画-WG の活動内容】

2017 年度、国際標準化・企画-WG は以下の活動に注力します。

① 半導体&システム設計技術委員会内で提案された規格案を国際標準にする活動。IEC 63055/IEEE Std 2401™-2015(下記)の改定やモデルに関して標準化が必要と判断された規格に対して国際標準化の戦略を立案します。

#### ②EDA のハードウェア記述言語の動向把握と研究

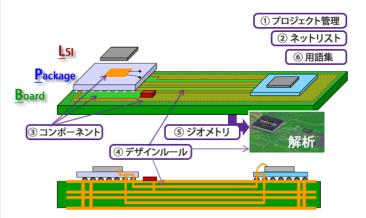
EDA のハードウェア記述言語(VHDL、Verilog-HDL、System Verilog、System C等) やシステム設計と連動した設計言語(パワーフォーマット: IEEE 1801 等) の動向を把握し、内容を研究するとともに、IEEE standardization committee, Design Automation Standards Committee に参加し協力関係を構築します。

#### 【LPB-SC の活動内容】

IEC 63055/IEEE Std 2401<sup>™</sup>-2015 LPB 標準フォーマットは、旧EDA 技術専門委員会 /LPB-WG の主導で制定されました。

このフォーマットは、下図に示す6つの要素で構成されています。LPB全体の設計情報を共有し、性能・コストのバランス設計や品質向上に貢献することが期待されます。また、開発のサプライチェーンの中で情報のやり取りを統一し、必要な設計情報を流通しやすくすることにより、準備段階での情報収集時間を飛躍的に短縮します。小規模な模擬セットを想定した試行の結果、LPB標準フォーマットを使うことで詳細設計や検証にかかる時間を61%削減し、情報の待ち時間を2週間以上短縮することが出来ました。既に、市販 EDA ツールでの活用も始まり、設計現場への普及が進んでいます。これら設計効率改善への貢献かつ、初めての日本発 EDA 関連 IEEE 規格であることが評価され、平成27年度 JEITA 会長賞を受賞しています。

- 1. プロジェクト管理(M-Format)
- 2. ネットリスト(N-Format)
- 3. コンポーネント(C-Format)
- 4. デザインルール(R-Format)
- 5. ジオメトリ(G-Format)
- 6. 用語集 (Glossary)



IEEE Std 2401™-2015 LPB 標準フォーマットの構成

LPB-SC では、IEEE Std 2401™を改定し、改良と活用範囲の拡大(3 次元や熱設計への対応)を進めるとともに、展示・発表・フォーラムを通じて普及を図り、会員各社の設計環境構築・改善に寄与します。また、ボード・セット設計に必要な半導体モデル、LPB 全体シミュレーションの為の伝送路モデル、半導体設計の為の外部負荷パラメーターについて考察を行い、標準化を目指します。

#### 【その他の課題】

その他、車載、IoT を見据えた Power デバイスや通信規格、GHz 世代 Logic LSI の設計手法などの技術課題についても、国内外の関連機関と連携しながら標準化のターゲットを模索して行きます。

<2017 年度(平成29年度)組織体制>

主 査:福場(東芝)

副主査:大槻(リコー)

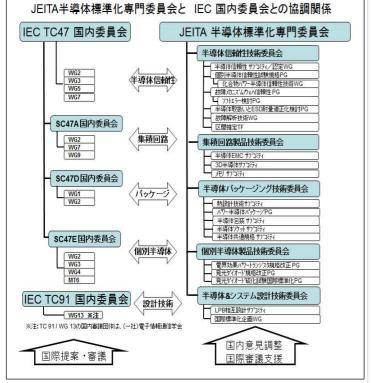
監事:登坂(富士通アドバンストテクノロジ)

参加企業:17社(順不同・敬称略)

(株)東芝、(株)リコー、ルネサスエレクトロニクス(株)、パナソニック(株)、(株)ソシオネクスト、ソニー(株)、(株) デンソー、キヤノン(株)、セイコーエプソン(株)、古河電気工業(株)、(株)村田製作所、富士通(株)、(株)図研、日本シノプシス合同会社、メンター・グラフィックス・ジャパン(株)、(株)ジェム・デザイン・テクノロジーズ、アンシス・ジャパン株式会社

JEITA における半導体分野の標準化活動は、半導体標準化専門委員会において、固有製品技術に関わる「集積回路製品技術」、「個別半導体製品技術」の標準化活動と、製品に共通な技術である「半導体信頼性技術」、「半導体パッケージ技術」、「半導体設計技術」の標準化活動をしています。 JEITA では WTO/TBT 協定遵守の観点から JEITA 規格を IEC 国際規格にすることを主眼とし、経済産業省から IEC 国内審議団体業務の委託を受け、IEC の半導体標準化委員会(TC47)における審議文書の提案・検討・回答処理を支援しています。

さらに国際標準化を目指すことから、デファクト世界標準規格を策定している米国工業会 JEDEC や米国電気電子学会 IEEE とも協調し活動しています。



#### 1. JEITA における技術・標準化活動と IEC 国際標準化活動

半導体標準化専門委員会では、半導体デバイスについての標準化規格(用語、特性項目、特性の評価(測定)方法、環境試験および耐久性試験方法など)や設計技術に関して、IEC を中心にした国際標準化活動を行っています。

製品技術分野の委員会活動として集積回路製品技術小委員会、個別半導体製品技術小委員会、および製品に跨る共通技術分野の委員会活動として半導体信頼性技術小委員会、半導体パッケージング技術小委員会、半導体設計技術小委員会の5つのグループに分かれて、半導体製品・設計に関わる標準化等の幅広い活動を行っています。

#### 1.1 集積回路製品技術委員会

メモリ関連の標準仕様では、近年多様化する中でJEDEC標準に日本の要求も反映させたグローバル・スタンダード化を目指しています。JEDECのコミティ/サブコミティ/タスクグループの各主要ポストを確保することで、策定段階での日本の影響力を高めます。半導体 EMC(電磁両立性)関連では、IEC標準規格の策定を重視し検討技術委員会への参画と標準規格への国内意見の反映を行います。また加盟会社で共同実証実験や EMC シミュレーション等も行い、最新情報の収集にも貢献します。3D 半導体や 3D モジュール関連では、SoC や ASIC 等のロジックチップ間のインターフェイスに着目し、物理的仕様の定義である物理層と、接続確認信号の受け渡しを行うリンク層の標準化議論を進めます。

#### 1.2 個別半導体製品技術委員会

トランジスタ、ダイオードをはじめ発光ダイオードなど、ディスクリートデバイスの特性や測定方法などの標準化規格作成に取り組んでいます。またIEC/TC47の SC47Eにおける、マイクロ波デバイス、パワーデバイス、発光ダイオードなどのIEC 規格の制定や改正に関し、標準化活動の支援をしています。

昨年度は、JEITA 規格改正が完了した絶縁ゲートバイポーラトランジスタ規格 (ED-4562B) 化の IEC 提案を開始し、日本発となる IEC 規格提案の LED 硫化試験法 についての審議も開始しています。 JEITA 規格は、電界効果パワートランジスタの JEITA 規格(ED-4561A) の改正および発光ダイオード の JEITA 規格(ED-4912)の改正、マイクロ波デバイス規格(ED-4359)の改正について着手しています。

#### 1.3 半導体信頼性技術委員会

「半導体信頼性試験規格」、「半導体の認定試験計画に関するガイドライン」、「ソフトエラーに関する試験法ガイドライン」、「ウェハレベル故障メカニズムと試験方法」の改正検討とともに、「半導体取り扱いとESD耐量適正化ガイドライン」を制定し、JEITA 規格類として標準化を進めるとともにIEC/TC47 直属 WG である「耐候性・機械強度試験(信頼性試験)(WG2)」や「ウェハレベル信頼性試験(WG5)」への新規および改正等の各種提案を行うなど、今後も積極的に国際標準化活動を推進して行きます。また、新たに制定する「寿命試験の試験時間・試験個数の決定手順」、「個別半導体信頼性認定ガイドライン」の規格類を含め、一般の方々も参加可能なセミナーの開催を実施し、規格・ガイドラインの周知・普及に努めて行きます。

#### 1.4 半導体パッケージング技術委員会

顧客の利便性を考慮し、同じプリント基板に何社もの半導体が載せられるよう、設計ガイドラインや調査内容の報告書を発行しています。パッケージ外形のみならず、後工程全体の標準化テーマも審議すべく技術委員会の名称を半導体パッケージから半導体パッケージングに致しました。審議案件として、パッケージ外観基準、パッケージ用サブストレートの外観基準、パッケージ名称及び組立に関する用語の統一、出荷用包装材のデザインガイドや用語集、熱設計に必要となる半導体モデルの規格化や材料物性測定法についてのガイドラインなどがございます。本年度から、パワー半導体パッケージの審議もスタート致しました。

#### 15 半導体&システム設計技術委員会

電子機器の機能・性能を決定するシステム LSI の設計技術に関わる活動を行っています。設計技術およびそれに関わる標準化の動向を調査・検討し、発展・推進を図り、更には国内外の関係業界の発展に寄与することを目的として取り組んでいます。国際標準化機関IEC の SC47A および TC91/WG13 の国内委員会や標準化関連組織(IEEE/DASC、IEEE-SA 等)と連携して活動しています。具体的には、LSI・パッケージ・ボード(LPB)を相互的に扱う設計環境の標準化のため、JEITA LPB 標準フォーマットを 2013 年 IEEE に提案し、2015 年 11 月に初の日本発 EDA 関連 IEEE 規格制定となりました。今後、Dual Logo として IEC で国際標準となる予定です。本フォーマットにより、LPB 全体の設計情報を共有し、性能・コストのバランス設計や品質向上に貢献することが期待され、既に、EDA ツールでの活用が始まり、設計現場への普及が進んでいます。

#### 2. JEDEC などとの国際協調活動

JEITAでは積極的に国際標準化を推進しており、1990年以来、JEITAの活動から 国際標準化になった規格は既に 100 件を超えています。また半導体業界では、ビジネス上世界的に認知度が高い米国の工業会である JEDEC(半導体技術協会)を無視できないことから、半導体標準化専門委員会では、JEDECと関連する技術分野毎に、IECを視野に置いた標準規格の情報交換とハーモナイズ活動を行っています。

#### 2.1 集積回路製品技術

メモリ製品の標準化は、ビジネスのタイミングに合わせ、ビジネスに直結する規格作りが必要なことから「標準化規格開発期間の短い JEDEC」の JC42,JC45, JC63, 64, 11, 16 への直接提案活動を行っています。主なものとして、JC42, JC45 では汎用SDRAM 単体仕様(JESD79 関係、 JESD209 関係) およびモジュール仕様(JESD21 関係) の規格更新を進めています。 JC63 では POP(SiP 3D Package on Package) 規格を2005 年に JEITA 委員会社などが提案し標準化開始、現在に至ります。 JC16 では非終端デジタル IC の広電源電圧範囲の CMOS DC インターフェースの標準化および低電圧 IC サブコミッティ案件 について 2009 年に JEDEC へ提案を行い、 JEDEC 規格化 (JESD8-23)を実現しました。 Flash メモリのインターフェイス規格としては、 JC64 でeMMC(JESD-84)および UFS(JESD-220)の規格更新を進めています。

#### 一般社団法人電子情報技術産業協会/半導体標準化専門委員会関連 規格類の紹介

JEITA では、IEC や ISO を中心とした国際標準化機関の活動に積極的に取り組んでいます。国際議長・幹事・副幹事を 20 名以上選出し、国内審議団体として委託を受けている国 内委員会は 30 以上にのぼります。世界各国で行われる国際会議にも積極的に委員を派遣し、国際標準化活動を展開しています。

組織体制は、共通部門のほか各分野別に標準化委員会を設置し、JEITA の事業分野であるオーディオ・ビジュアル、コンピュータ、情報システム、産業・社会システム関連はもとより、電子部品、電子材料、半導体、電子ディスプレイなどに関する標準化を推進しています。

JEITA に関係する規格には、IEC、ISO、JTC1 等の国際規格、JIS 等の国内規格がありますが、これらを補完するために、業界団体規格として JEITA 規格類を制定・発行しています。オーディオ・ビジュアル機器から、情報通信機器、電子応用機器、電子部品、半導体、ディスプレイ、実装システムに至るまで、540 件以上の JEITA 規格類(JEITA 規格・暫定規格・技術レポート)を発刊し、英語版も 150 件以上発行しています。

JEITA 規格の制定にあたっては、参加委員各社の専門家と、関連する業界団体や大学から有識者を募り、関連委員会傘下に専門の審議機関を設置し検討しています。

また、過去に制定した規格類は、定期的に見直しを行い、改正を行うことで、日々進歩する技術に対応し、IT・エレクトロニクス業界の技術発展、製品の安全性、ビジネス発展に寄与しています。

#### 【規格類一覧】(担当委員会別)

ED-7800

EDR-7311A

FDR-7312

EDR-7313

#### ☆半導体パッケージング委員会 半導体パッケージ外形規格作成に関する基本事項 FD-7300A ED-7301A 集積回路パッケージ個別規格作成マニュアル ED-7302A 集積回路パッケージデザインガイド作成マニュアル ED-7303C 集積回路パッケージの名称及びコード ED-7304 BGA 規定寸法の測定方法 ED-7304-1 SOP 規定寸法の測定方法 集積回路パッケージ外形設計指標(ガルウイングリード) ED-7305A 昇温によるパッケージ反りの測定方法と最大許容値 ED-7306 集積回路パッケージ個別規格[TSOP(1)] FD-7311-1 集積回路パッケージ個別規格[TSOP(2)] ED-7311-2 集積回路パッケージ個別規格(1.0mm ピッチ T-BGA) ED-7311-3A 集積回路パッケージ個別規格(1.27mm ピッチ T-BGA) ED-7311-4A 集積回路パッケージ個別規格(SRAM/Flash 用 FBGA) ED-7311-5A 集積回路パッケージ個別規格(60/90ピン FBGA) ED-7311-6 ED-7311-7 集積回路パッケージ個別規格(0.5mm ピッチ P-FBGA) ED-7311-8 集積回路パッケージ個別規格(0.8mm ピッチ P-FBGA) ED-7311-9A 集積回路パッケージ個別規格[P-BGA (キャビティアップタイプ)] 集積回路パッケージ個別規格[P-BGA(キャビティダウンタイプ)] FD-7311-10A 集積回路パッケージ個別規格(119/153ピン P-BGA) ED-7311-11A 集積回路パッケージ個別規格[52/64/80/100ピンロープロファイルクワッドフラットパッケージ] ED-7311-12 ED-7311-13A 集積回路パッケージ個別規格(P-SON) 集積回路パッケージ個別規格(C-LGA) ED-7311-16A ED-7311-17 集積回路パッケージ個別規格(P-ZIP) 集積回路パッケージ個別規格(P-ILGA) ED-7311-18 集積回路パッケージ個別規格(P-SOP) ED-7311-19 集積回路パッケージ個別規格(P-SSOP) FD-7311-20 集積回路パッケージ個別規格(P-HSOP) FD-7311-21 集積回路パッケージ個別規格(P-QFN) ED-7311-22 ED-7311-23 集積回路パッケージ個別規格(PGA) 集積回路パッケージ個別規格(P-QFP) ED-7311A 集積回路パッケージデザインガイド ファインピッチ・ボールグリッドアレイ及びファインピッチ・ランドグリッドアレイ ED-7316 ED-7318 集積回路パッケージデザインガイドプラスチックスモールアウトラインノンリードパッケージ(P-SON) ED-7324 集積回路パッケージデザインガイド プラスチッククワッドフラットノンリードパッケージ 集積回路パッケージデザインガイド シリコン・ファインピッチ・ボールグリッドアレイ及びシリコン・ファインピッチ・ランドグリッドアレイ ED-7335 半導体パッケージ規定寸法の測定方法(集積回路) FD-7401-4 ED-7500B 半導体デバイスの標準外形図(個別半導体) ED-7502A 個別半導体パッケージ個別規格作成マニュアル ED-7607 マトリクス固定トレイデザインガイド マトリクストレイデザインガイド ED-7617 ED-7618 半導体包装用語集 ED-7631 半導体製品出荷用マガジンに於けるリサイクルのための表示方法 ED-7701A 半導体ソケット用語 テスト・アンド・バーンイン・ソケット試験方法 ED-7702A 半導体ソケットデザインガイドオープントップタイプボールグリッドアレイ(BGA) FD-7711 半導体ソケットデザインガイド オープントップタイプ ファインピッチ・ボールグリッドアレイ及びファインピッチ・ランドグリッドアレイ(FBGA/FLGA) ED-7712 ED-7713 半導体ソケットデザインガイド クラムシェルタイプ ファインピッチ・ボールグリッドアレイ及びファインピッチ・ランドグリッドアレイ(FBGA/FLGA) ED-7714 半導体ソケットデザインガイド クラムシェルタイプボールグリッドアレイ及びランドグリッドアレイ(BGA/LGA) ED-7715 半導体ソケット個別規格オープントップ[54/66 ピン TSOP(タイプ 2)] ED-7716 半導体ソケット個別規格オープントップ(メモリ用 FBGA)

(新規制定予定)半導体パッケージの過渡熱回路網モデル(個別半導体) 集積回路パッケージデザインガイドプラスチッククワッドフラットパッケージ(P-QFP)

集積回路パッケージデザインガイド薄形スモールアウトラインパッケージ(タイプ I)(TSOPI)

集積回路パッケージデザインガイド薄形スモールアウトラインパッケージ(タイプ II)(TSOPII)

☆半導体パッケージ委	員会 (前ページからの続き)
EDR-7314A	集積回路パッケージデザインガイドシュリンクスモールアウトラインパッケージ(P-SSOP)
EDR-7315B	集積回路パッケージデザインガイド/ボールグリッドアレイ
EDR-7317	集積回路パッケージデザインガイド縦形表面実装パッケージ(SVP)
EDR-7319	集積回路パッケージデザインガイドクワッドフラット J-リードパッケージ(QFJ)
EDR-7320	集積回路パッケージデザインガイドスモールアウトラインパッケージ(SOP)
EDR-7321	集積回路パッケージデザインガイドクワッドフラット I-リードパッケージ
EDR-7322	集積回路パッケージデザインガイドプラスチックデュアルインラインパッケージ
EDR-7323A	集積回路パッケージデザインガイドピングリッドアレイ(PGA)
EDR-7325	集積回路パッケージデザインガイドクワッドフラットノンリードパッケージ
EDR-7326A	集積回路パッケージデザインガイドヒートシンク付スモールアウトラインパッケージ
EDR-7327	集積回路パッケージデザインガイドシングル・インライン・パッケージ
EDR-7328	集積回路パッケージデザインガイドジグザグインラインパッケージ(PーZIP)
EDR-7329	集積回路パッケージデザインガイドプラスチックインタースティシャルランドグリッドアレイパッケージ
EDR-7330	集積回路パッケージデザインガイドプラスチックスモールアウトライン J リードパッケージ(PーSOJ)
EDR-7331	集積回路パッケージデザインガイドクワッドテープキャリヤパッケージ及びそのキャリア
EDR-7332	集積回路パッケージデザインガイドデュアルテープキャリヤパッケージ(タイプ 1、タイプ 2)
EDR-7333	積層パッケージデザインガイド ファインピッチ・ボールグリッドアレイ及びファインピッチ・ランドグリッドアレイ
EDR-7334	代表的熱変形測定方式の比較評価結果
EDR-7335	半導体パッケージ用語集(第一部 パッケージ名称及び部位名称)
EDR-7336	半導体製品におけるパッケージ熱特性ガイドライン
EDR-7336	Package thermal characteristics guideline in semiconductor products
EDR-7337	2 チップ積層型半導体パッケージの熱特性ガイドライン
EDR-7337	Thermal characteristics guidelines of two chip stacked semiconductor packages
EDR-7338	熱電対を利用した測定ガイドライン
EDR-7605	半導体包装の鉛フリー表示方法ガイド
EDR-7619	半導体用エンボスキャリアテープの納入リール
EDR-7711	半導体ソケットデザインガイドオープントップボールグリッドアレイ(BGA)
EDR-7714	半導体ソケットデザインガイド クラムシェルタイプ ボールグリットアレイ/ランドグリッドアレイ
EDR-7717	半導体ソケット位置決めシミュレーション技術レポート[FLGA タイプソケット]
EDR-7718	半導体ソケット位置決めシミュレーション技術レポート(FBGA タイプソケット)
EDR-7719	半導体ソケット位置決めシミュレーション技術レポート[QFP タイプソケット]
☆集積回路製品技術委	
ED-5001A	3.3V 電源電圧仕様
ED-5001A ED-5002A	3.3V 電源電圧仕様 2.5V 電源電圧仕様
	<del></del>
ED-5002A	2.5V 電源電圧仕様
ED-5002A ED-5003A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様
ED-5002A ED-5003A ED-5004A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5006A ED-5007	<ul> <li>2.5V 電源電圧仕様</li> <li>1.8V 電源電圧仕様</li> <li>1.5V 電源電圧仕様</li> <li>1.2V 電源電圧仕様</li> <li>1.0V 電源電圧仕様</li> <li>統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格</li> </ul>
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 れのV 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5007 ED-5101A ED-5102A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 6.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5006A ED-5007 ED-5101A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ)
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006 ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 たー化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC)
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準)
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準)
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 (1.0V 電源電圧仕様 (1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告 i委員会 個別半導体デバイス用語
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 (1.0V 電源電圧仕様 (1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告 i委員会 個別半導体デバイス用語
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.10V 電源電圧仕様 1.10V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告 i委員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び測定方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504 ☆個別半導体製品技術 ED-4002A ED-4359 ED-4511B	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.10V 電源電圧仕様 1.10V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告 1番員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び測定方法 ダイオードの定格・特性及び試験方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504 ☆個別半導体製品技術 ED-4002A ED-4359 ED-4511B ED-4521	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 3.0V 電源電圧仕様 4統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 3.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告 1.委員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び測定方法 ダイオードの定格・特性及び試験方法 3 端子サイリスタの定格・特性及び試験方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504 ☆個別半導体製品技術 ED-4002A ED-4359 ED-4521 ED-4522	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL 2) 標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) フロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL 2) 差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告 i委員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び測定方法 ダイオードの定格・特性及び試験方法 3 端子サイリスタの定格・特性及び試験方法 3 端子サイリスタの定格・特性及び試験方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5007 ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504 ☆個別半導体製品技術 ED-4002A ED-4359 ED-4511B ED-4521 ED-4522 ED-4541A ED-4561A	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法 1/0 インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 2.5V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告 i委員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び試験方法 ダイオードの定格・特性及び試験方法 3 端子サイリスタの定格・特性及び試験方法 パワートランジスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504 ☆個別半導体製品技術 ED-4002A ED-4359 ED-4511B ED-4521 ED-4521 ED-4522 ED-4561A ED-4562B	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール (PEMM) 動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2) 差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告  「委員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び試験方法 ダイオードの定格・特性及び試験方法 ターンオフサイリスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504 ☆個別半導体製品技術 ED-4002A ED-4359 ED-4511B ED-4521 ED-4521 ED-4522 ED-4541A ED-4561A ED-4562B ED-4912	25V 電源電圧仕様 18V 電源電圧仕様 15V 電源電圧仕様 15V 電源電圧仕様 12V 電源電圧仕様 10V 電源電圧仕様 10V 電源電圧仕様 10V 電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 33V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_3)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 25V スタブ直列終端型論理(SSTL_2) 標準機能仕様(電源電圧 25V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール(PEMM)動作仕様標準 25V スタブ直列終端型論理(SSTL_2)差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告  「委員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び測定方法 ダイオードの定格・特性及び試験方法 3 端子サイリスタの定格・特性及び試験方法 第一ンオフサイリスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法 絶縁ゲートバイポーラトランジスタの定格・特性及び試験方法 発光ダイオード
ED-5002A ED-5003A ED-5004A ED-5005A ED-5006A ED-5101A ED-5102A ED-5103A ED-5301 ED-5302 ED-5511 ED-5512 ED-5513 ED-5514 ED-5515 EDR-5202 EDR-5504 ☆個別半導体製品技術 ED-4002A ED-4359 ED-4511B ED-4521 ED-4521 ED-4522 ED-4561A ED-4562B	2.5V 電源電圧仕様 1.8V 電源電圧仕様 1.5V 電源電圧仕様 1.2V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 1.0V 電源電圧仕様 統一化広電源電圧 CMOS インターフェース規格 音声出力用集積回路測定方法 テレビジョン受信機用集積回路測定方法 リニア集積回路測定方法(演算増幅器及びコンパレータ) 固体撮像素子測定方法 1/O インタフェースモデル技術標準(IMIC) シンクロナス・グラフィック RAM 及びシンクロナス・ビデオ RAM 標準機能仕様 3.3V 用スタブ直列終端型論理(SSTL_2)標準機能仕様(電源電圧 3.3V デジタル集積回路インタフェース標準) プロセッサ搭載メモリ・モジュール (PEMM) 動作仕様標準 2.5V スタブ直列終端型論理(SSTL_2) 差動入力信号規格 ASIC 基本性能評価ガイドライン シリコンディスク RAM 無し用途 64M ビット級フラッシュメモリ仕様検討報告  「委員会 個別半導体デバイス用語 マイクロ波半導体デバイスの特性及び試験方法 ダイオードの定格・特性及び試験方法 ターンオフサイリスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法 電界効果パワートランジスタの定格・特性及び試験方法

EDR-4901

LED 及びフォトカプラ用語

#### ☆半導体信頼性技術委員会

ED-4701/001A 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(基本事項)

寿命試験の試験時間、試験個数の決定手順 ED-4701/002

ED-4701/100A 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験 I) ED-4701/200A 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(寿命試験Ⅱ) FD-4701/301A 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(強度試験 I-1) ED-4701/302 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(強度試験 I-2) 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(強度試験Ⅱ) ED-4701/400A ED-4701/500A 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(その他の試験)

FD-4701/600 半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法(個別半導体特有の試験)

ED-4702C 表面実装半導体デバイスの機械的強度試験方法 ED-4703 半導体デバイスの工程内評価及び構造解析方法 半導体デバイスの工程内評価及び構造解析方法(追補1) ED-4703-1 半導体デバイスのウエハープロセスの信頼性試験方法 ED-4704A

ED-4705 FLASH メモリの信頼性試験方法 EDR-4701C 半導体デバイスの取扱いガイド

半導体デバイスの品質・信頼性試験方法規格対照表 FDR-4702

EDR-4703A ベアダイの品質ガイドライン

EDR-4704A 半導体デバイスの加速寿命試験運用ガイドライン

EDR-4705A JEITA ソフトエラー試験ガイドライン EDR-4706 FLASH メモリの信頼性ガイドライン

EDR-4707 LSI の故障メカニズム及び試験方法に関する調査報告

EDR-4708B 半導体集積回路 信頼性認定ガイドライン

EDR-4709 システムレベル ESD に対応した半導体の ESD 試験方法検討とシステムへの半導体部品実装方法、取り扱いガイドライン

半導体取り扱いと ESD 耐量適正化のガイドライン EDR-4710

EDR-4711A 個別半導体信頼性認定ガイドライン

EDR-4712/100 SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法 (Part 1:結晶欠陥の分類)

FDR-4712/200 SiC ウェーハの結晶欠陥の非破壊検査方法 (Part 2:光学検査手法による SiC エピタキシャル層欠陥の検査方法)

EDR-4713 化合物パワー半導体信頼性試験方法ガイドライン

【JEITA規格類の入手方法に関するお問い合わせ】(9:00-17:00) JEITA サービスセンターまでお願い致します。【TEL】03-5218-1086 [URL] http://www.jeita.or.jp/japanese/public\_standard/

JEITA 標準化センター 担当事務局までお願い致します。

【専門委員会・技術委員会への参加に関するお問い合わせ】

[TEL]03-5218-1059 [URL] http://semiconjeitassc.jeita-sdtc.com/

#### -般社団法人 電子情報技術産業協会について

一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA: Japan Electronics and Information Technology Industry Association of Japan)は、電子機器、電子部品の健全な生産、貿 易及び消費の増進を図ることにより、電子情報技術産業の総合的な発展に資し、わ が国経済の発展と文化の交流に寄与することを目的とした業界団体です。電子材料 から電子部品・デバイス、最終製品に至るまで幅広い分野の様々な課題に取り組ん でいます。

世界中がインターネットで結ばれ、エレクトロニクス技術とIT(情報技術)が、様々な 形でグローバルに浸透しています。このエレクトロニクス技術の進化とITの進展によ り、情報・通信・映像・音声等の技術が融合して、新しいシステムや製品が生み出さ れ、経済社会のみならず、人々の生活や文化に至るまで、従来の枠組みを超えた大 きな変化がもたらされています。

当協会は、まさに 21 世紀のデジタル・ネットワーク時代を切り拓いていくことを使命と しており、電子情報技術の発展によって、人々が夢を実現し、豊かな生活を享受でき るようになることを願っております。

このため、政策提言や技術開発の支援、新分野の製品普及等の各種事業を精力 的に展開するとともに、地球温暖化防止等の環境対策にも積極的に取り組んでいま す。組織体制は、内外にわたる各分野の課題について調査・研究・審議するため、理 事会・政策役員会の下に、総合事業部門として総合政策部会と、6 つの課題別委員 会、製品事業部門として 5 つの分野別部会及び関西支部運営部会を設置していま す。

また、各分野別部会・課題別委員会の下には、さらに多数の事業委員会、専門委員 会などが設置されており、会員会社は希望する委員会に参加することができます。

所掌する産業分野は、サーバやパソコンを含むコンピュータ関連、情報端末機器 から、無線通信機器、放送機器、電子計測器、医用電子機器、道路交通システム機器 などの「インダストリアル機器」、液晶テレビやプラズマテレビ、デジタル放送受信機 器、ケーブルテレビ機器、DVD/ブルーレイ機器、デジタルビデオカメラ、オーディ オ機器、カーナビゲーションシステムなとの「コンシューマ機器」、更には集積回路

やディスクリート半導体、液晶ディスプレイ、PDPなどの「電子デバイス」、受動部品 や機構部品などのほか、組立品、電子材料を含む「電子部品」、その他、EDI関連、R FID関連、ソフトウェア、ソリューションサービスなど、多岐に亘っています。

当協会は、これらの産業規模にして40兆円を超える規模を持つIT・エレクトロニク ス産業を担う、わが国最大級の業界団体として、政策提言や税制・規制改革等の要 望、環境問題への取組み、知的財産保護への取り組み、各種調査統計事業の充実に 努めています。

また、様々な報告書や資料類の発行、国際標準化活動や業界規格の制定、国際会 議の開催、海外調査団の派遣、様々なテーマでの講演会やセミナーの開催、「CEAT EC JAPAN」に代表される展示会なども実施しています。





【出典】 http://www.jeita.or.jp/japanese/about/pdf/about.pdf

【JEITA 入会に関するお問い合わせ】

入会に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

一般社団法人 電子情報技術産業協会 総務部 TEL:03-5218-1050

# JEITA